

Сведения об оппоненте

по диссертации ХАШАФА АДЕЛ ХАМУД ДЕРХЕМ

«Структура и свойства сверхпроводящих пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, полученных нетронным распылением», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния

Фамилия Имя Отчество оппонента	Билалов Билал Аругович
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	01.04.07 – физика конденсированного состояния
Ученая степень и отрасль науки	Д.ф.-м.н., ДК № 013002, Решением ВАК от 15.039.2002 № 12д/34, физико-математические науки
Ученое звание	Профессор, по кафедре Экспериментальной физики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный технический университет»
Занимаемая должность	Заведующий кафедрой «Микроэлектроника»
Почтовый индекс, адрес	367025, РД, г. Махачкала, ул. Шамиля, 70
Телефон	89289415388
Адрес электронной почты	bil-bilal@yandex.ru
Публикации	1. Г.К. Сафаралиев, Б.А. Билалов, М.К.Курбанов, В.И.Алтухов, И.С.Касьяненко, А.В.Санкин/Расчет высоты барьера Шоттки на контакте металла с полупроводниковым твердым раствором $(\text{SiC})_{1-x}(\text{AlN})_x$ /Микроэлектроника, 2015, том 44, №6, С. 453-458. 2. Г.К.Сафаралиев, Б.А. Билалов, М.К Гусейнов / Исследование структуры и состава пленок $(\text{SiC})_{1-x}(\text{AlN})_x$ полученных магнетронным распылением/ Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2015. №3. Т. 38. С. 15-20.

3. В.И. Алтухов, И.С. Касьяненко, А.В. Санкин, Б.А. Билалов, А.С. Сигов/ Расчет барьера Шоттки и вольт-амперных характеристик структур металл-твердые растворы на основе карбида кремния./ Физика и техника полупроводников, 2016, том 50, вып. 9, С. 1190– 1194.
4. A.Sh. Asvarov, S.Sh. Akhmudov, A.Kh. Abduev, A.K. Akhmedov, M.A. Aliev, B.A. Bilalov/ Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering./ Journal of nano- and electronic physics Vol. 8 № 4(2), 04053(4cc) (2016).
5. V.I. Altukhov, B.A. Bilalov, A.V. Sankin, S.V. Filipova/ Modeling of Schottky Barrier Height and Volt-Ampere Characteristics for Transition Metal-solid Solution (SiC) $_{1-x}$ (AlN) $_x$./Journal of nano- and electronic physics Vol. 8 №4 (1), 04003(4pp) (2016), С. 04003-1 - 04003-4.

Экспонент
 д.ф.-м.н., зав.кафедрой
 «Микроэлектроника»



Билалов Б.А.

Зерно:

Проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», профессор, д.э.н.

